(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-41773

(43)公開日 平成6年(1994)2月15日

社東芝堀川町工場内 (74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

(51) Int.Cl. ⁵ C 2 3 G 1/14 C 2 3 F 1/40 C 3 0 B 33/10	識別記号	庁内整理番号 9271-4K 8414-4K 7821-4G	FI	技術表示箇所
H01L 21/304	341 L	8728 – 4M	:	審査請求 未請求 請求項の数8(全 9 頁)
(21)出願番号	特願平5-103191		(71)出願人	000003078 株式会社東芝
(22)出願日	平成5年(1993)4月	28日	(72)発明者	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 平 塚 八 郎
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平4-125025 平 4 (1992) 5 月18日		(10)/0/14	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工場内
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	宫 下 守 也 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 社東芝堀川町工場内
			(72)発明者	

(54) 【発明の名称】 半導体ウェーハ処理液

(57)【要約】

【目的】 パーティクル、金属の双方に対し良好な除去 効果を有するとともに、洗浄工程の簡略化を図ることが できる半導体ウェーハ用処理液を提供すること。

【構成】 水性溶媒とアルカリ性成分とからなるウェーハ処理液であって、該処理液中に、ウェーハ表面への金属の吸着作用を抑制する吸着防止剤が添加されてなることを特徴とする半導体ウェーハ処理液。

1

【特許請求の範囲】

.

【請求項1】水性溶媒とアルカリ性成分とからなるウェ ーハ処理液であって、該処理液中に、ウェーハ表面への 金属の吸着作用を抑制する吸着防止剤が添加されてなる ことを特徴とする、半導体ウェーハ処理液。

【請求項2】アルカリ性成分が、NH4 OH、NaO H、KOH、コリン ([(CH3) 3NCH2 CH2 O H] OH) およびこれらの混合物からなる群より選択さ れた少なくとも1種からなる、請求項1に記載の半導体 ウェーハ処理液。

【請求項3】吸着防止剤が、-CH2 PO3 H2 を構造 式中に有する化合物からなる、請求項1に記載の半導体 ウェーハ処理液。

【請求項4】吸着防止剤が、エチレンジアミン-N, N, N´, N´-テトラキス (メチレンホスホン酸)、 ニトリロトリス(メチレンホスホン酸)、エチレンジア ミン-N, N --ピス (メチレンホスホン酸) およびこ れらの混合物からなる群から選択された少なくとも1種 からなる、請求項3に記載の半導体ウェーハ処理液。

【請求項5】吸着防止剤が、エチレンジアミン-N, N, N', N'-四酢酸、トランス-1, 2-シクロへ キサジアミンーN, N, N′-N′-四酢酸、N, N-ジ(ヒドロキシルエチル)グリシン、1、3-ジアミノ プロパン-2-オール-N, N, N', N'-四酢酸、 ジエチレントリアミン-N, N, N', N", N"-五 酢酸、エチレンジアミン-N, N'-二酢酸、エチレン ジアミン-N, N'-二プロピオン酸、N-エドロキシ エチルエチレンジアミン-N, N', N'-三酢酸、グ リコールエーテルジアミン-N, N, N'-N'-四酢 酸、ヘキサメチレンジアミン-N, N, N', N'-四 30 -ピラゾロン、 α , β , γ , δ -テトラフェニルポルフ 酢酸、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸、イミノ二酢酸、 1, 2-ジアミノ-N, N, N', N'-四酢酸、二ト リロ三酢酸、ニトリロ三プロピオン酸、トリエチレンテ トラミン-N, N, N', N", N"'' - 六酢 酸、4, 7-ジフェニル-2, 9-ジメチル-1, 10 -フェナントロリン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4,4'-ピス(ジメチルアミノ) ジフェニルアミン、NーペンゾイルーNーフェニルヒド ロキシルアミン、N-シナモイル-N-フェニルヒドロ キシルアミン、3, 3′-ビス [N, N-ジ (カルボキ 40 シルメチル) アミノメチル] フルオロセイン、4-メチ ルンベリフェロン-8-メチレンイミノ二酢酸、1-(1-ヒドロキシー4-メチルー2-フェニルアゾ) -2-ナフトール-4-スルフォン酸、2,5-ジクロロ -3, 6-ジヒドロキシーp-ペンゾキノン、ジアンチ ピリルメタン、1-(2-ヒドロキシアゾ)-2-ヒド ロキシペンゼン、2.2′-ジピリジル、ベンジジン-3, 3′-ジカルポキシル-N, N′-四酢酸、2-フ

リルジオキシム、3、3′-ジ(N-カルボキシメチル アミノメチル) - θ - クレソルスルフォンフタレイン、 2. 2'-ビベンゾオキサゾリン、3,3'-ジ(N-カルポキシメチルアミノメチル)チモールスルフォンフ タレイン、プルプリック酸、2,9-ジメチル-1,1 $0-フェナントロリン、<math>\theta$ ーニトロフェニルアルソン 酸、2-二トロソー5-(N-プロピル-N-スルフォ プロピルアミノ) フェノール、2-ニトロソー5-(N -エチルーNースルフォプロピルアミノ)フェノール、

10 2-ヒドロキシー1-(2-ヒドロキシー4-スルフォ -1-ナフチルアゾ) -3-ナフトイック酸、1-(2) **−ピリジルアゾ)−2−ナフトール、2,2′−2″−** ニトリロトリエタノール、4,4,4ートリフルオロー -テトラメチル-3,5-ヘプタネジオン、4,4,4 ジオン、1, 1, 1-トリフルオロー2, 4-ペンタネ ジオン、4,4,4-トリフルオロー1-(2-チエニ ル) -1, 3-プタネジオンおよびこれらの混合物から 20 なる群から選択された少なくとも1種からなる、請求項 1に記載の半導体ウェーハ処理液。

【請求項6】吸着防止剤の添加量が、1~200mg/リ ットルの範囲である、請求項1に記載の半導体ウェーハ

【請求項7】 p H 5~7の水溶液中に、ジエチレントリ アミン-N, N, N', N", N"-五酢酸、ジキノリ ル-8, 8' -ジスルフィド、4 -クロロ-6 -(2, 4-ジヒドロキシフェニルアゾ) -1-ヒドロキシベン ゼン-2-スルフォン酸、1-フェニル-3メチル-5 ィンテトラスルフォン酸、2,4,6-トリス(2-ピ リジル)-s-トリアジンからなる群から選ばれた少な くとも1種あるいは2種以上の混合物が1~200mg/ リットルの範囲で添加されてなる、半導体ウェーハ処理

【請求項8】HClおよび/またはHFを含む、請求項 7に記載の半導体ウェーハ処理液。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体ウェーハの処理液 に関し、特に、高清浄度な仕上り表面が要求されるシリ コンウェーハの洗浄に好適な半導体ウェーハ処理液に関 するものである。

[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】従来 の半導体ウェーハの洗浄液としては、下表に示されるよ うに、酸性の洗浄液とアルカリ性の洗浄液とに大別する ことができる。

除去可能なもの 成

(1) $HCI + H_2 O_2 + H_2 O$

重金属

酸性の (2) H₂ SO₄ +H₂ O₂ +H₂ O

(3)

洗浄液 (3) HF+H2 O

3

(4) HNO₃ +HC I

(5) HF+HNO₃ +H₂ O

有機物、重金属

重金属、酸化膜

重金属

シリコン

アルカ (6) NH4 OH+H2 O2 +H2 O

有機物、パーティクル

リ性の (7) KOH+H₂ O

シリコン酸化物

洗浄液 (8) C₅ H₁₅NO₂ +H₂O₂ +H₂O

有機物、パーティクル

上述した従来の洗浄液のうち、酸性洗浄液においては、 洗浄処理後のパーティクルの除去効果が必ずしも良好で はなく、また洗浄後にウェーハ表面に微量の有機物や水 分が残存するという問題がある。さらに、洗浄液が酸性 であることから酸ミストの拡散により製造装置やクリー ンルーム等に腐食が発生し易くなるという問題もある。

【0003】一方、アルカリ性洗浄液においては、金属 不純物の除去が困難であり、洗浄液中の金属が液中濃度 に対応したウェーハ表面に吸着し、これによる逆汚染現 象が発生するという問題がある。

【0004】ところで、上述した欠点を緩和する方法と 20 して、酸性またはアルカリ性の洗浄液のうちの一方の洗 浄液を用いて一旦洗浄を行った後、他方の洗浄液で再び 洗浄することが考えられるが、この方法では洗浄工程が 繁雑化し、洗浄コストの上昇を招くという新たな問題を 生じさせる。

【0005】さらに、特公昭53-20377号、特開 昭63-114131号、特開平3-219000号な らびに特開平4-130100号は、キレート剤を添加 してなる洗浄液を用いて半導体ウェーハを洗浄する技術 が開示されている。

【0006】しかしながら、これらの従来技術が開示す る洗浄液は、洗浄液の安定性ならびに洗浄効果の維持特 性において、必ずしも十分満足のいくものではない。ま た、従来提案されているキレート剤ないし錯化剤、たと えば、特開平3-219000号に開示されているクエ ン酸、酒石酸、カテコール、レゾルシン、ピロガロー ル、トリエタノールアミン、エチレンジアミン、エチレ ンジアミン四酢酸などの錯化剤は、特定の金属(たとえ ば、Fe)の吸着を抑制する点においては効果が認めら れものの、洗浄に際して使用薬品や洗浄容器中に混入し 40 荒れ抑制剤として作用する。 やすいCu、Ni、Zn、Alなどの金属成分に対して は、吸着抑制効果が必ずしも高くない。

[0007]

【課題を解決するための手段および作用】本発明は従来 技術の問題点を解消するためになされたものであり、パ ーティクル、金属不純物の双方に対し良好な除去効果を 有するとともに、洗浄工程の簡略化を図ることができる 半導体ウェーハ用処理液を提供することを目的とする。

【0008】本発明による半導体ウェーハ用処理液は、

10 あって、該処理液中に、ウェーハ表面への金属の吸着作 用を抑制する吸着防止剤が添加されてなることを特徴と するものである。

【0009】本発明によるウェーハ用処理液は、従来ア ルカリ系のウェーハ処理液中で発生し易かったウェーハ 表面への微量金属成分の吸着を効果的に抑制するキレー ト剤などの成分を含有しているので、単独のウェーハ処 理液による洗浄によって、従来の酸性ウェーハ処理液と アルカリ性ウェーハ処理液の双方の長所を兼ね合せた洗 浄効果を得ることが可能となる。

【0010】さらに本発明においては、キレート剤を選 択することによって、洗浄液の安定性ならびに洗浄効果 の維持特性において特にすぐれた処理液を提供すること が可能である。

【0011】さらに本発明においては、pH5~7の範 囲の水溶液にウェーハ表面への金属の吸着作用を抑制す る吸着防止剤が添加されてなる処理液をも提供すること ができ、上述したと同様の効果を発現させることもでき

【0012】以下、本発明のウェーハ用処理液について 詳細に説明する。本発明のウェーハ用処理液は、水性溶 媒とアルカリ性成分とから基本的になるが、この場合の アルカリ性成分としては、NH4 OH、NaOH、Na OH、KOH、コリンおよびこれらの混合物からなる群 より選択された少なくとも1種が好ましく用いられ得 る.

【0013】本発明においてはさらにH2O2、などの 酸化剤を適宜添加することができる。この場合の酸化剤 は、アルカリ性成分によるシリコンエッチング作用の抑 制剤およびエッチング作用によるシリコンウェーハ表面

【0014】アルカリ性成分の含有量はNH₄OH/H 2 O2 / H2 O系を例にすると0. 1~20 重量%が好 ましく、さらに好ましくは、1~10重量%である。酸 化剤の添加量としては0.5~10重量%が好ましく、 さらに好ましくは、1~5重量%である。

【0015】水性媒体としては、水が好ましく用いられ る。吸着防止剤は、ウェーハ表面への金属の吸着作用を 抑制する成分であって、キレート剤その他の成分が用い られ得る。具体的には、エチレンジアミン-N,N,N 水性溶媒とアルカリ性成分とからなるウェーハ処理液で50 $\hat{}$, N $\hat{}$ - テトラキス(メチレンホスホン酸)、ニトリ

5

ロトリス(メチレンホスホン酸)、エチレンジアミンー N, N - ビス (メチレンホスホン酸) およびこれらの 混合物からなるリン酸系のキレート剤の群から選択され た少なくとも1種、あるいは、エチレンジアミン-N, N, N', N'-四酢酸、トランス-1, 2-シクロへ キサジアミンーN, N, N'-N'-四酢酸、N, N-ジ (ヒドロキシルエチル) グリシン、1, 3-ジアミノ プロパン-2-オール-N, N, N', N'-四酢酸、 ジエチレントリアミン-N, N, N', N", N"-五 酢酸、エチレンジアミン-N, N'-二酢酸、エチレン 10 せて添加することによって、さらに良好な金属除去効果 ジアミン-N, N'-ニプロピオン酸、N-エドロキシ エチルエチレンジアミン-N, N', N'-三酢酸、グ リコールエーテルジアミン-N, N, N'-N'-四酢 酸、ヘキサメチレンジアミン-N, N, N', N'-四 酢酸、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸、イミノ二酢酸、 1, 2-ジアミノ-N, N, N', N'-四酢酸、ニト リロ三酢酸、ニトリロ三プロピオン酸、トリエチレンテ トラミン-N, N, N', N", N"'', N''' - 六酢 酸、4、7-ジフェニル-2、9-ジメチル-1、10 フェナントロリン、4,4'-ピス(ジメチルアミノ) ジフェニルアミン、N-ベンゾイル-N-フェニルヒド ロキシルアミン、Nーシナモイル-N-フェニルヒドロ キシルアミン、3, 3'-ビス[N, N-ジ(カルポキ シルメチル) アミノメチル] フルオロセイン、4-メチ ルンベリフェロン-8-メチレンイミノ二酢酸、1-(1-ヒドロキシー4-メチル-2-フェニルアゾ) -2-ナフトール-4-スルフォン酸、2,5-ジクロロ -3, 6-ジヒドロキシ-p-ベンゾキノン、ジアンチ ピリルメタン、1-(2-ヒドロキシアゾ)-2-ヒド 30 ルカリ洗浄の双方の利益を得ることができる。なお、本 ロキシベンゼン、2,2'-ジピリジル、ベンジジン-3, 3′-ジカルボキシル-N, N′-四酢酸、2-フ リルジオキシム、3,3'-ジ(N-カルボキシメチル 2. 2′-ビベンゾオキサゾリン、3,3′-ジ(N-カルポキシメチルアミノメチル) チモールスルフォンフ タレイン、プルプリック酸、2,9-ジメチル-1,1 酸、2-ニトロソ-5-(N-プロピル-N-スルフォ プロピルアミノ) フェノール、2-ニトロソー5-(N 40 ウェーハ処理液と、このアルカリ性ウェーハ処理液に3 -エチル-N-スルフォプロピルアミノ) フェノール、 2-ヒドロキシ-1-(2-ヒドロキシ-4-スルフォ -1-ナフチルアゾ)-3-ナフトイック酸、1-(2 - ピリジルアゾ) - 2 - ナフトール、2、2′-2″-ニトリロトリエタノール、4,4,4ートリフルオロー 1-フェニル-1, 3-プタネジオン、2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー3、5ーヘプタネジオン、4、4、4 ートリフルオロー1ー(2-フリル)-1,3-プタネ ジオン、1, 1, 1-トリフルオロー2, 4-ペンタネ ジオン、4、4、4-トリフルオロ-1-(2-チエニ 50

ル) -1. 3-プタネジオンおよびこれらの混合物から なる群から選択された少なくとも1種が用いられ得る。 上述したうちでも、安定性ならびに洗浄効果の長期間に わたる維持の点で、リン酸系のキレート剤、たとえば、 エチレンジアミン-N, N, N´, N´-テトラキス (メチレンホスホン酸)、ニトリロトリス (メチレンホ スホン酸)、およびエチレンジアミン-N. N´-ピス (メチレンホスホン酸) が特に好ましい。

【0016】本発明においては、上記吸着防止剤を組合 を得ることが可能である。このような効果を得るための 好ましい組合せとしては、次のようなものがある。

[0017] たとえば、NH4 OH (30%): H2 O 2 (35%): H₂ O=1:1:10 (容積比) にNT POなどのリン酸系キレート剤を5mg/リットル程度添 加したものである。

【0018】吸着防止剤の添加量は、1~200mg/リ ットルの範囲が好ましく、さらに好ましくは、3~50 mg/リットルである。1mg/リットル未満の添加では添 -フェナントロリン、4,7-ジフェニル-1,10-20 加効果が発現し難く、一方、1000mg/リットルを超 えて添加すると、吸着防止剤中の不純物による洗浄液の 純度劣化や、吸着防止剤起因のウェーハ表面異状発生の 危険性が高くなるので好ましくない。

> 【0019】本発明のウェーハ用処理液は、アルカリ性 洗浄を基本作用としているが、後述する実施例の結果か らも理解されるようにウェーハ表面への金属吸着は効果 的に抑制され、しかもアルカリ性洗浄における利点であ るすぐれたパーティクル除去効果を低減させることもな い。したがって、1回のみの洗浄によって酸性洗浄とア 発明においては、アルカリ性水性媒体に代えて、pH5 ~7の範囲の水溶液としても適用することが可能であ り、このような態様においても同様の効果を得ることが できる。

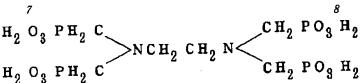
[0020]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。

NH₄ OH (30%) : H₂ O₂ (35%) : H₂ O が、容積比で1:1:10である従来条件のアルカリ性 種のキレート剤、ONTPO、OEDTPO、OEDD POを、各々、1 mg/リットル2 mg/リットル、4 mg/ リットル添加した計8種のウェーハ処理液を使用し、通 常の鏡面ウェーハ (CZ, Nタイプ) を70℃の液温で 10分間洗浄後10分間水洗し、洗浄効果を比較した。 上記キレート剤の化学式は以下の通りである。

①NTPO: ニトロトリス (メチレンホスホン酸) [0021]

【化1】



②EDTPO:エチレンジアミン-N, N, N´, N´

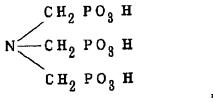
*③EDDPO:エチレンジアミン-N, N´-ピス(メ チレンホスホン酸)

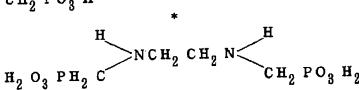
- テトラキス (メチレンホスホン酸) [0022]

[0023]

【化2】

[化3]





吸着防止剤の添加量(重量比)は以下の通りである。

キレート剤	1 mg∕i	2 mg/1	4 mg/1
NTPO	A – 1	A – 2	A – 4
EDTPO	-	B-2	B-4
EDDPO	_	C-2	C-4

洗浄ならびにその評価は以下の条件で行った。

得られた結果を、下表に示す。

評価枚数:2枚/条件 ウェーハ処理液温:70℃ [0024]

30 【表1】

洗净時間:10分間

第 1 表

[強制汚染ウェーハに対する洗浄効果]

評価枚数:	2枚/条件	
-------	-------	--

10

	添加量	мс	n	パーティクル数		
吸養防止剤	mg/lit	Fe	A 1	Z n	Νi	(但/ウェーハ)
無し	0	12	9200	120	20	5
ж. С		13	4500	65	22	4
	1	18	4700	130	24	8
	(A-1)	17	4500	100	25	2
NTPO	2	(-)	4700	1.4	(-)	4
	(A-2)	0.8	4900	1.8	(-)	3
	4	(-)	5100	1.2	(-)	1
	(A-4)	(-)	5800	1.0	(-)	.5
	2	(-)	5200	0.9	(-)	7
EDTPO	(B-2)	1.8	4500	0.9	(-)	3
	4	(-)	5000	1.1	(-)	8
	(B-4)	1.7	4700	1.0	(-)	5
	2	1.9	4800	2.7	6.0	4
EDDPO	(C-2)	6.6	4900	2.7	6.7	6
	4	2.2	5200	1.3	(-)	2
	(C-4)	5.4	5500	1.4	4.8	- 6
洗	净前	85	8700	190	130	118
	444	63	8000	180	110	125
検 出	限界	0.6	4.0	0.1	8.8	0.2gm

(-) は検出限界以下

上記表から明らかなように、吸着防止剤の添加によっ て、金属 (Fe, Al, Zn) のウェーハ表面への吸着 量が低減したことが確認された。吸着防止効果は、吸着 防止剤の添加量にほぼ比例して向上するが、添加量が1 た。また、吸着防止効果は、キレート剤の種類によって 若干差異が認められた(特にAI)。

【0025】不純物パーティクルの除去効果についても 上記表に示すように、0. 1 μm以上のパーティクルに ついての洗浄前後の増減挙動は、キレート剤添加の有

無、添加キレート剤の種類により大きな変化は認められ なかった。

【0026】さらに、シリコンのエッチング速度につい ては、下表2に示すように、70℃の液温で100分間 ェアリットル未満では低減効果が乏しいことが確認され 40 洗浄時のシリコンのエッチング厚はキレート剤を添加し ても大きな変化は見られなかった。したがって、吸着防 止剤添加による悪影響のないことが確認された。

[0027]

【表2】

2 表

キレート剤	NTPO		E D 1	rpo	ED	DPO	添加なし
添加量mg/lit	1	2	1	2 1		2	
エッチング厚 (A/20分)	120	118	110	123	125	121	120

実施例2

NH4 OH (30%): H2 O2 (35%): H2 Oが 容積比で1:1:5である従来条件のアルカリ性水溶液 ウェーハ処理液と、このアルカリ性ウェーハ処理液に3 種のキレート剤、①2-フリルジオキシム、②2,21 -ビベンゾオキサゾリン、③1-(2-ピリジルアゾ) -2-ナフトールを各々、10,100,500 mg/リ 20 ットル添加した計10種のウェーハ処理液を使用し、鏡 面仕上げの直径150mmのCZN型ウェーハを70℃の*

*液温で10分間洗浄後10分間水洗いし、洗浄効果を比 較した。洗浄効果の比較方法は、洗浄後にウェーハの鏡 面仕上げ面を弗化水素酸水溶液の液滴を走査することで 表面に残存している金属を液滴中に溶解し、この液滴を フレームレス原子吸光法で分析する方法による。その結 果を表3に示す。

12

[0028] 【表3】

第 3 表

洗净被NH₄OH:H₂O₂:H₂O-1:1:5

各条件10枚の平均値

添加 剤	添加量								
DAN AND PER	mg/l	Fe	Al	2 n	Νi	Cu			
無し	0	65	310	150	70	35			
	10	42	250	140	42	18			
① 2-フリルジオキシム	100	38	238	115	3. 2	10			
·	500	30	239	82	3. 0	5. 2			
	10	52	110	83	38	33			
② 2. 2' ービベンゾオキサゾリン	100	3. 2	16	42	42	15			
	500	3. 1	8	45	37	14			
	10	18	53	40	32	18			
③ 1-(2-ピリジルアン)-	100	17	10	1. 2	5. 1	1. 2			
2-ナフトール	500	10	2	1. 0	4. 5	0. 91			

実施例3

HF(49%): H2 Oが容積比で1:100である酸

ハ処理液に α , β , γ , δ - テトラフェニルポルフィン テトラスルフォン酸を100㎏/リットル添加した計2 性水溶液(従来条件)のウェーハ処理液と、このウェー 50 種のウェーハ処理液を使用し、実施例2と同様の手順で 13

洗浄効果を比較した。その結果を表4に示す。

*【表4】

[0029]

洗净液HF:H,0□1:100

各条件8枚の平均値

14

滋加	剤	添加量	金函线存刻度(atcos/ca²) × 1 0 10							
160x 7/U	ויא	□g/l	Fe	Al	Zn	Ni	Cu			
無し		0	1. 3	5. 8	3. 2	1. 1	12			
α, β. γ. δーテト ポルフィンテトラスル	ラフェニル ⁄フォン酸	100	1. 2	6. 2	3. 0	0. 92	0. 31			

実施例4

コリン (5%): H2 O2 (35%): H2 Oが容積比 で1:5:30である従来条件のアルカリ性水溶液ウェ ーハ処理液と、このアルカリ性水溶液に2種のキレート 剤、④エチレンジアミン-N, N, N', N'-テトラ キス (メチレンホスホン酸)、⑤エチレンジアミン-N, N'-ビス (メチレンホスホン酸) を、各々100%20

※mg/リットルあるいは④を50mg/リットルと⑤を50 mg/リットル同時に添加した計4種のウェーハ処理液を 使用し、実施例2と同様の手順で洗浄効果を比較した。 その結果を表5に示す。

[0030]

【表5】

第 5 表

洗浄液コリン: H , O , : H , O = 1:5:30

各条件4枚の平均値

蒸	ba	剤	透加型	金属残存间度(atoms/on²) ×10 ¹⁰)	
1694	ψu	A1	ng/1	F	, 6	A 1		Z	n	Ni		C	u
無し			0	æ	32	28	0	5	6	83	3	3	1
④エチレンジ N', N' テ	トラキ		100	0.	91	3.	1	1.	2	5.	1	٥.	91
⑤エチレンジ -ビス (メチ			100	1.	3	5.	3	0.	93	4.	0	0.	82
(4)			⊕ 50 ⑤ 50	0.	88	4.	0	0.	81	3.	2	1.	3

以上、実施例2~4の結果に示される様に吸着防止剤の ことが確認された。吸着防止効果は吸着防止剤の添加量 にほぼ比例して向上するが、実施例4で示したキレート 剤④エチレンジアミン-N, N, N', N'-テトラキ ス(メチレンホスホン酸)の添加量と金属残存量の関係 を示す図1から分かるように、添加量は1~200mg/ リットルで大きな効果があることが確認された。吸着防 止効果はキレート剤の種類によって差異が認められる。 このように、キレート剤を各種混合することにより吸着 防止効果を高めることが可能となる。

るキレート剤はそれぞれの液性において金属に対するキ 添加によって金属のウェーハ表面への吸着量が低減した 40 レート効果が最も発揮される。また、実施例4で示した ような-CH2 PO: H2 をその構造に有するリン酸系 のキレート剤が例示したキレート剤の中で最も効果が高 いことが認められた。

実施例5 (安定性の比較)

6種類のキレート剤(NTPO、EDTPO、EDDP O、EDTA (エチレンジアミン四酢酸)、NTA (ニ トリロ三酢酸)、CyDTA(トランス-1,2-シク ロヘキサンジアミン-N, N, N´, N´-四酢酸)) を、同一の原料ロットから取った過酸化水素水(重量濃 【0031】アルカリ性水溶液、酸性水溶液に添加され 50 度35%) へ夫々10-4mol /リットル濃度になるよう

に溶解させた。

【0032】その後、各々の溶液を、夫々、1日、10日、20日、30日ならびに40日間室温(25℃)の部屋で保管したのち、コリンおよび純水と混合し(混合後の組成比が、コリン0.1%、過酸化水素4%になるように調製)、70℃の温度で10分間、シリコーンウェーハの洗浄を行った。まず、さらに純水で10分間リンスしたのち、乾燥し、ウェーハ表面にフッ化水素酸水溶液を走査させて表面に残存している金属成分を液滴中に溶解させ、この液滴をフレームレス原子吸光法によって分析し、残存する鉄成分の量を測定した。

【0033】得られた分析結果を図2に示す。この図からわかるように、キレート剤がEDTA、NTA、CyDTAの場合は、キレート剤添加後、10日ないし20日経過することによって洗浄後におけるFe残存濃度が高くなる。これに対して、リン酸系のキレート剤(EDTPO、EDDPO、NTPO)の場合においては、40日経過後であっても、依然としてFe残存濃度が低レベルに止まることが確認された。すなわち、上記実施例におけるキレート剤はいずれも酸であるが、前者のグル20一プは化合物中に-CH2COOHを有するのに対し

て、後者のグループは化合物中に-CH2 PO3 H2を 有し、両者の作用効果の相違は、基の相違に起因するも のと考えられる。すなわち、-CH2 PO3 H2基を有 するキレート剤は、過酸化水素溶液中における安定性に

すぐれ、洗浄効果を長期間にわたって維持する上で好ま しいことが確認された。

16

[0034]

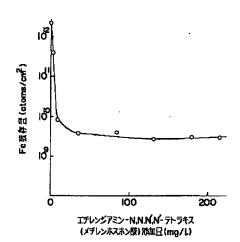
【発明の効果】本発明によるウェーハ処理液は、ウェーハ処理液に金属の吸着作用を抑制する吸着防止剤が添加 10 されているので、ウェーハ表面への金属吸着は効果的に抑制され、しかもアルカリ性洗浄における利点であるすぐれたパーティクル除去効果を低減させることもない。したがって、1回のみの洗浄によって酸性洗浄とアルカリ洗浄の双方の利益を得ることができる。さらに本発明によれば、洗浄プロセスが簡略化され、洗浄コストの低減化が可能となる(薬液使用量の節減、時間短縮)。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における、キレート剤濃度とFe吸着量の関係を示す図。

【図2】キレート剤添加後の経過日数と洗浄後の残存金 属濃度の関係を示す図。

【図1】



[図2]

